

Silicon Diode

1N4385

600V / 1A

DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 73/74

1 N 4383... 1 N 4586

Silizium-Miniatur-Gleichrichter

Nennstrom	1 A
period. Spitzensperrspannung	200...1000 V

Glasgehäuse JEDEC DO-29
56 A 2 nach DIN 41 883
Gewicht ca. 0,4 g
Maße in mm



Grenzwerte

Typ	periodische Spitzensperrspannung U_{RRM} V		
1 N 4383	200		
1 N 4384	400		
1 N 4385	600		
1 N 4585	800		
1 N 4586	1000		
periodischer Spitzenstrom bei $\theta < 40^\circ$, $f > 15$ Hz	I_{FRM}	10	A
Stoßstrom für eine 50-Hz-Sinus- halbwellen ausgehend von $T_j = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	50	A
Verlustleistung in Sperrichtung bei $t < 20 \mu\text{s}$ bei $t < 100 \mu\text{s}$	P_{RSM} P_{RSM}	1 0,5	kW kW
Sperrschichttemperatur	T_j	175	$^\circ\text{C}$
Betriebs- und Lagerungs- temperaturbereich	T_U, T_S	-65...+175	$^\circ\text{C}$

1 N 4383... 1 N 4586

Kennwerte

Nennstrom in Einwertschaltung
mit Widerstandslast
bei $T_U = -65...+100\text{ }^\circ\text{C}$
bei $T_U = 150\text{ }^\circ\text{C}$

I_{FAV} 1 A
 I_{FAV} 0,3 A

Durchlaßspannung
bei $I_F = 1\text{ A}$, $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$

U_F <1 V

Sperrstrom
bei U_{RRM} , $T_U = 25\text{ }^\circ\text{C}$

I_R <10 μA

Wärmewiderstand
Sperrschicht - umgebende Luft

R_{thU} <80 K/W

Durchlaßkennlinien

zulässiger Richtstrom in Einwertschaltung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

